

陶瓷靶材

陶瓷靶材是物理气相沉积（PVD）或磁控溅射等工艺中，用来被高能粒子轰击，从而在基板上沉积出特定功能薄膜的陶瓷材料源，是芯片、显示器等现代电子工业中几乎是不可或缺的材料，具有高纯度、高致密度、成分和结构分布均匀的特点。高纯度是保证沉积薄膜性能稳定的基础，杂质会成为薄膜散射和吸收中心，严重降低薄膜的光学或电学性能，纯度通常要求 99.95%或更高；靶材致密度越高，气孔就越少，在溅射中不容易发生打火或者微粒飞溅（导致薄膜缺陷）；靶材成分分布均匀可以确保薄膜厚度和性能的均匀性。

材料	纯度	最大尺寸	致密度
Al_2O_3	4N	Dia100×8mm	>80%
BaFe_2O_7	4N	Dia80×8mm	>80%
BaTiO_3	4N	Dia100×8mm	>80%
$\text{Ba}_x\text{Sr}_{(1-x)}\text{TiO}_3$	4N	Dia80×8mm	>80%
BaZrO_3	4N	Dia100×8mm	>80%
$\text{Bi}_x\text{Y}_y\text{Fe}_5\text{O}_{12}$	3.5N	Dia80×8mm	70-80%
BiFeO_3	3.5N	Dia100×8mm	>80%
CeO_2	4N	Dia100×8mm	>80%
$\text{Ce}_x\text{Y}_y\text{Fe}_5\text{O}_{12}$	3.5N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{Dy}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$	4N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{Gd}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$	4N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{Tm}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$	4N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$	4N	Dia80×8mm	70-80%
ITO	4N	Dia100×8mm	>80%
NiFe_2O_4	3.5N	Dia100×8mm	>80%
MgO	4N	Dia100×8mm	>80%
PZT	4N	Dia100×8mm	>80%
PbZrO_3	4N	Dia100×8mm	>80%
PbTiO_3	4N	Dia100×8mm	>80%
SrTiO_3	4N	Dia100×8mm	>80%
$\text{Sr}_3\text{Al}_2\text{O}_6$	4N	Dia100×8mm	>80%
$\text{La}_x\text{Sr}_y\text{MnO}_3$	4N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{La}_x\text{Ca}_y\text{MnO}_3$	4N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{La}_x\text{Sr}_y\text{CuO}_3$	4N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{La}_x\text{Ca}_y\text{CuO}_3$	4N	Dia80×8mm	70-80%
$\text{La}_x\text{Sr}_y\text{CoO}_3$	4N	Dia80×8mm	70-80%
SrRuO_3	4N	Dia80×8mm	>60%
TiO_2	4N	Dia100×8mm	>80%
YSZ	4N	Dia100×8mm	>80%
ZnO	4N	Dia100×8mm	>80%
Y_2O_3	4N	Dia100×8mm	>80%
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$	4N	Dia80×8mm	>80%
.....			